

時間分解多探針 STM を用いた単層 WS₂ の局所励起子ダイナミクス評価

○水野 良祐¹, 茂木 裕幸¹, 和田 尚樹², 宮田 耕充²,
嵐田 雄介¹, 吉田 昭二¹, 武内 修¹, 重川 秀実^{1*}

¹筑波大学理工学群, ²東京都立大学理学部

Evaluation of local exciton dynamics of single-layer WS₂ using time-resolved multi-probe STM

○Ryosuke Mizuno¹, Hiroyuki Mogi¹, Naoki Wada², Yasumitsu Miyata²,
Yusuke Arashida¹, Shoji Yoshida¹, Osamu Takeuchi¹, Hidemi Shigekawa^{1*}

¹ Univ. of Tsukuba, ² Tokyo Metropolitan Univ.

遷移金属ダイカルコゲナイト系(TMDCs)二次元半導体は、Si に匹敵する高い移動度や可視光領域に対応するバンドギャップを持つこと、組成選択の自由度が高いことなどから高パフォーマンスかつ極薄膜の電子・光電子デバイス応用へ向けて盛んに研究されている。また、2 次元構造に由来する閉じ込め効果の存在や、弱いスクリーニング効果のために励起子が高い束縛エネルギーを持ち、室温でも安定に存在することが知られている。そのため、2 次元励起子を用いた新たな情報伝達デバイスへの応用も期待されており、実用化に向けて励起子の時間・空間的なダイナミクスをより詳細に計測することが重要である。励起子ダイナミクスに関する研究はこれまで、フォトルミネッセンス法等による光学的な計測によって進められてきたため、空間分解能はサブマイクロメートル程度に限られてしまい、グレインバウンダリ等の微細構造における特性の解明は困難だった。

本研究では、当研究グループが開発した多探針走査トンネル顕微鏡にポンプ-プロープ光学系を組み合わせることで探針直下の局所的な励起子ダイナミクスが測定できることを明らかにした。Fig 1 に試料の光学顕微鏡像を示す。試料は SiO₂/Si 基板上に化学気相成長(CVD)法により作成した WS₂/WSe₂ 面内ヘテロ構造を使用した。図中矢印で示したヘテロ界面付近では、WSe₂ 領域は比較的平坦であったのに対し、WS₂ 領域ではグレインバウンダリにより誘起される波状の構造が確認できた*。この波状構造を STM により形状観察すると同時に、2 nm 毎に遅延時間スキャンを行い各探針位置毎の時間分解スペクトルを取得した。それぞれ単一成分の指数関数によりフィッティングして得られた時定数を Fig 2 に示す。得られた時定数は波状構造の頂上部と底部で異なり、頂上部の方が底部よりも大きな値となった。この理由のひとつとして、WS₂ と基板間の界面の粗さによるポテンシャルの揺らぎによって、底部では局所的に光生成励起子の EEA(exciton-exciton annihilation)過程が活発化していることが考えられる。本研究結果は单分子層の光電子デバイスの理解と将来の応用に必要不可欠な知見をもたらすものである。

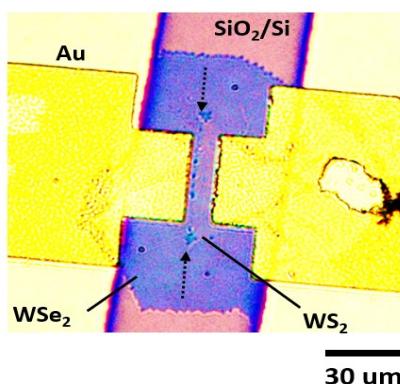


Fig 1 試料光学顕微鏡像

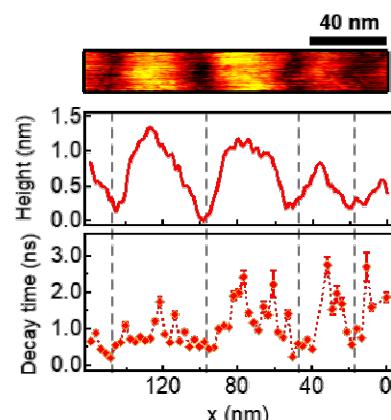


Fig 2 上から STM 形状像,
高さラインプロファイル, 時定数

* H. Liu, D.Chi, Scientific Reports 5, 11756 (2015)